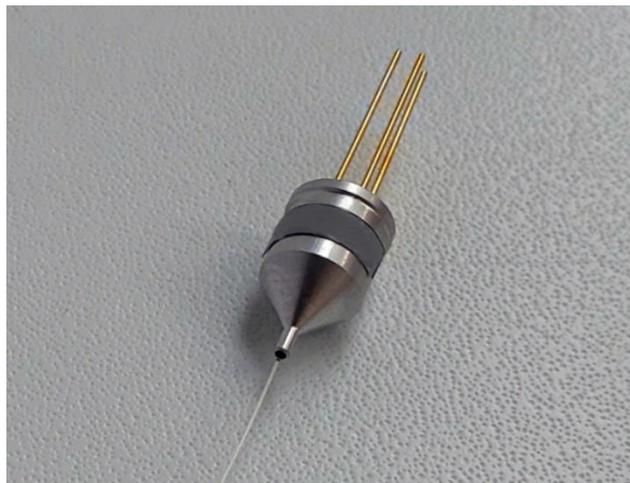


ТФД-50Р InGaAs PIN фотодиод

ОСОБЕННОСТИ:

- Наличие ТУ
- Низкие ёмкость и темновой ток
- Сборка с многомодовым радиационно-стойким волокном



ЭЛЕКТРО-ОПТИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

Параметр	Символ	мин	тип	макс	Единицы	Условия
Диапазон спектральной чувствительности	R_{λ}	900	1540	1700	нм	1, 2, 3
Токовая монохромная чувствительность	S_{λ}	0.8	0.85		А/Вт	$\lambda=1540$ нм, 2, 3, 4
Темновой ток	I_{λ}		3	5	нА	2, 3, 5
Рабочее (обратное) напряжение	U_{λ}		-5	-3	В	3, 4
Емкость	C		0.5	1.0	пФ	5
Время нарастания, время спада фронта импульса	T_{λ}, T_{λ}		1.5	2	нс	5

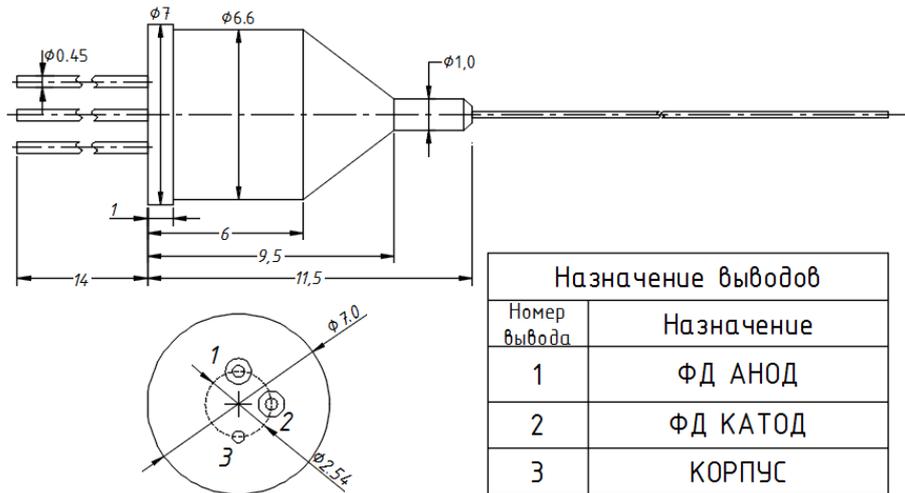
Примечания:

- 1 – На выходе многомодового световода CM(R)
- 2 – При максимальной детектируемой мощности 2 мВт
- 3 – В непрерывном режиме
- 4 – В импульсном режиме
- 5 – При рабочем обратном напряжении минус 5 В

Информация для заказа:

ТФД-50Р

**Корпус
тип В**



ПРЕДЕЛЬНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ:

Параметр	мин	макс	Единицы	Условия
Температура хранения	-40	85	°С	
Рабочая температура	-40	55	°С	
Смена температур	-55	70	°С	
Относительная влажность при 25°С		98	%	
Температура пайки		260	°С	10 секунд
Синусоидальные вибрации, частота	5	100	Гц	30 секунд
Случайные вибрации, частота	20	2000	Гц	60 секунд